



Made in Russia



公司介绍, 旗下品牌, 出口商, 机械和设备 (制造商、供应商、服务)

Crocus Nano Electronics

Crocus Nano电子公司是俄罗斯唯一一家从事300毫米硅片上电子元件的开发和BEOL生产（在生产最后阶段，生产线的后端实现技术操作的全周期）的公司，设计标准为90/55纳米。该公司还能够为潜在客户在硅片上应用磁层的工程和工厂服务，以及基于创新类型的非易失性存储器的产品。



Crocus Nano Electronics

Crocus Nano电子公司是俄罗斯唯一一家从事300毫米硅片上电子元件的开发和BEOL生产（在生产的最初阶段，生产线的后端实现技术操作的全周期）的公司，设计标准为90/55纳米。该公司还能够为潜在客户提供在硅片上应用磁层的工程和工厂服务，以及基于创新类型的非易失性存储器的产品。

该公司是俄罗斯生产和开发使用MRAM（磁阻式随机存取存储器）和RRAM（电阻式随机存取存储器）技术的现代类型非易失性存储器的技术领导者。公司的产品包括RFID和微控制器，生物电子芯片，MRAM和RRAM内存芯片（嵌入式和独立式内存），工业电子的磁传感器，通信设备，汽车和消费电子。该公司拥有现代化的设备、先进的技术能力和，还提供300毫米晶圆的BEOL合同制造服务和工艺开发。企业的合作伙伴是最大的技术公司和制造商，如：国际商业机器公司（美国）、中芯国际集成电路制造公司（中国）、塔式半导体公司（以色列、日本）、上海华力微电子公司（中国）、阿德斯托科技公司（美国）等大型科技公司和制造商。如今，公司的生产能力已达每月4千片晶圆。生产设施总面积为6.9万平方米。

产品和服务

Crocus Nano Electronics的生产目录包括MRAM和RRAM存储芯片、磁性传感器、硅基插层、生物电子芯片、通信设备。此外，公司还提供300毫米晶圆上集成电路的合同生产和技术工艺的开发服务。MRAM和RRAM是下一代非易失性存储器技术。MRAM和RRAM是新一代的非易失性存储器技术，公司开发并准备生产MRAM和RRAM芯片。公司开发的MRAM芯片记录密度为1-4兆位，读写速度为35/90/120/150纳秒。它们具有低功耗，适用于记录数据和程序、缓冲和数据缓存。该技术是专门为集成到微控制器、微处理器和系统级芯片中而设计的，MRAM和RRAM芯片可以替代Flash、EEPROM和SRAM存储元件。在MRAM中，数据是通过存储元件的磁极化来记录的，这确保了高性能、无限重写周期和20年的能源独立性。MRAM存储器是低功耗设备的最佳选择，设计用于数据记录、程序、缓冲和数据缓存。MRAM存储器单元的集成在生产过程的末端（生产线后端）进行。这样一来，MRAM存储器可以与任何基本的CMOS器件一起使用。其中，该技术易于扩展，适用于广泛的应用，并可替代其他类型的嵌入式存储器。对于非标准的解决方案，Crocus Nano电子公司提供专门的复杂功能MRAM单元（模块）的开发。

产量



出口额


90% 的产品

*对世界市场的影响

联系信息



俄罗斯，莫斯科，Volgogradsky Prospekt 42号，5号楼

 +7 495 640-51-86

 info@crocusnano.com



